

## 研究成果報告書 (掲載期間 2023.11.1–2024.10.31)

### 審査学術論文

- (1) Yoshiyuki Hattori, Tetsu Kachi: Comparison of body diode switching characteristics of 650V power devices, IEICE (電子情報通信学会) Electronics Express, volume 21, 2024, Issue 19, pp.1–6.

### 学会発表

- (1) Yoshiyuki Hattori, Tetsu Kachi: Comparison of switching characteristics of 650V GaN power device and SiC/Si power devices, 14th International Conference on Nitride Semiconductors, 2023年11月, 福岡.
- (2) Takuma Yamaguchi, Katsuya Nomura, Yoshiyuki Hattori: Topology Optimization of Junction Termination Extension in Vertical GaN Power Device, 14th International Conference on Nitride Semiconductors, 2023年11月, 福岡.
- (3) 服部佳晋, 加地徹: 耐圧 650V 系パワーデバイスのボディダイオードのスイッチング特性比較, 電気学会産業応用部門大会, 2024年8月, 水戸市.

### 科研費採択

- (1) 服部佳晋, 野村勝也, 加地徹: 24K07597, 基盤研究(c), トポロジー最適化を用いた縦型 GaN パワーデバイスの構造設計技術, 2024.

### その他

- (1) 服部佳晋: 車載システム EMC コンソーシアム(名古屋工業大学産学官金連携コンソーシアム), パワーエレクトロニクスワーキングリーダー, 2024年6月.